

# 新生TELへ向けての経営方針

---

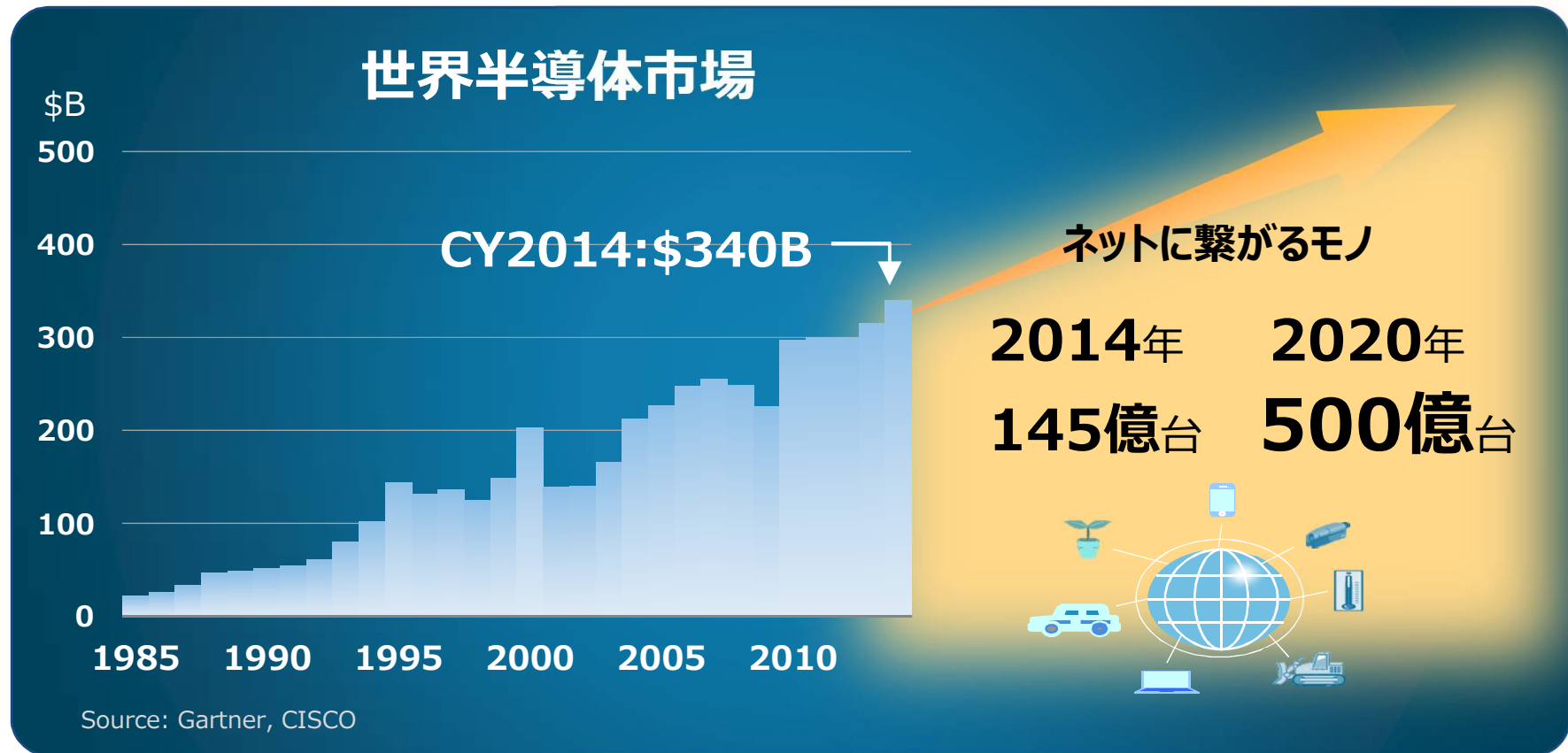
代表取締役社長、CEO 東 哲郎

2015年7月10日



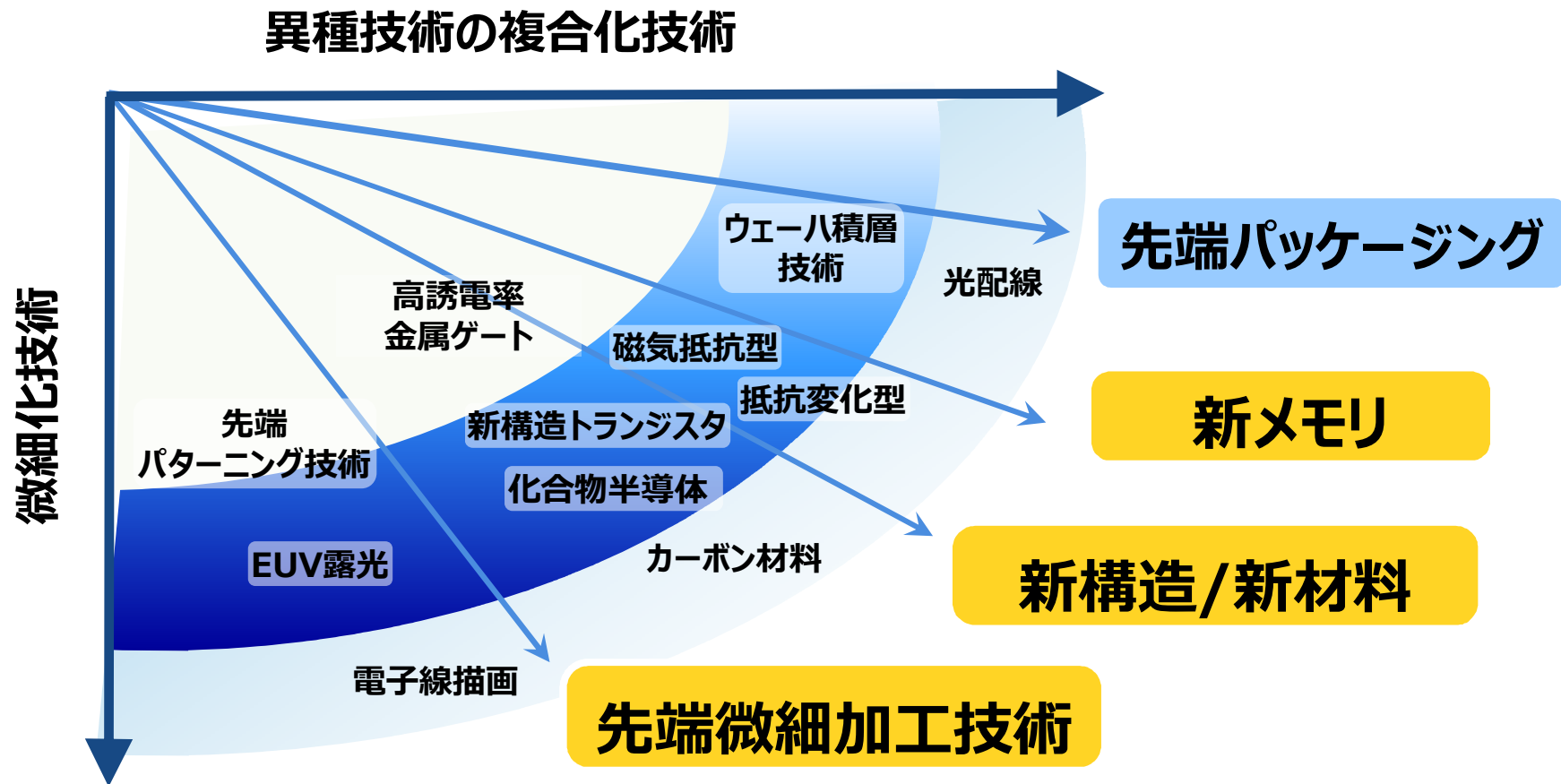
TOKYO ELECTRON

# 市場環境の変化：IoT時代が来る



## IoTが半導体用途を広げ、半導体市場が拡大

# 半導体産業におこる技術革新の方向性



多岐にわたる新技術が半導体の進化を支える

**革新的な技術力と、  
多様なテクノロジーを融合する  
独創的な提案力で、  
半導体産業とFPD産業に  
高い付加価値と利益を生み出す  
真のグローバルカンパニー**

# 中期経営方針

1. Best in Class
2. Best Fit in New Market

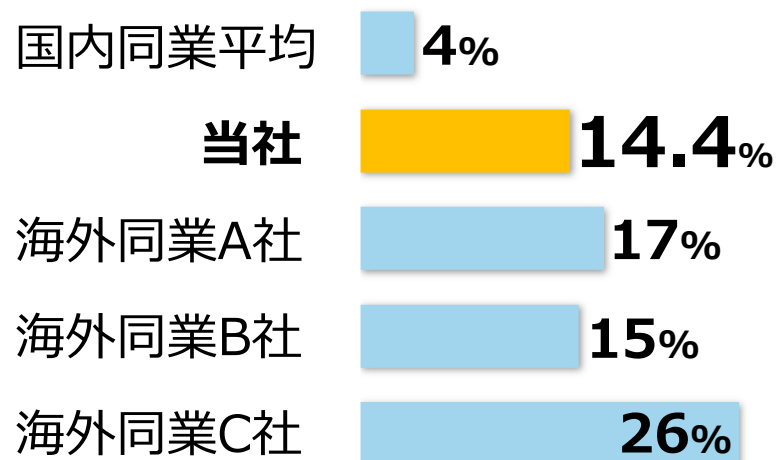


更なる飛躍に向けて対応力と経営基盤を強化

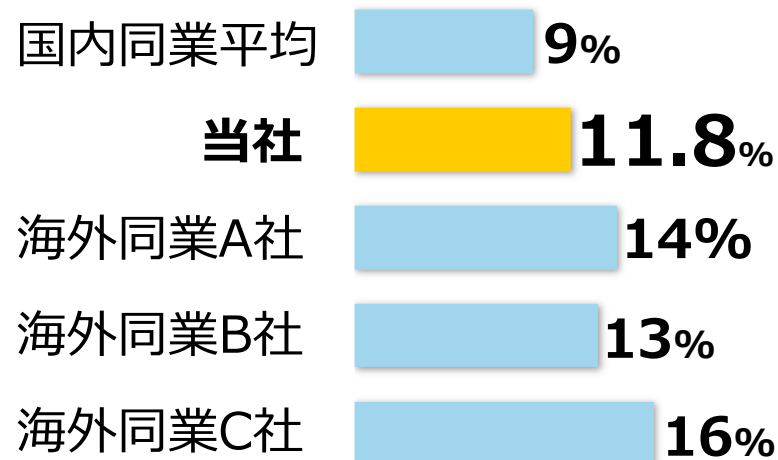
“Best in Class”

## ベンチマーク（直近の会計年度）

### 営業利益率



### ROE



改善中だが、海外勢からはまだ見劣り

“Best in Class”

## 新ファイナンシャル・モデル

半導体前工程製造装置 市場規模	\$30B	\$37B
売上高	7,200億円	9,000億円
営業利益率	20%	25%
ROE	15%	20%

目指すのは、グローバル水準

“Best Fit in New Market”

# グローバル成長戦略

---

**市場環境の変化**  
IoT時代

**顧客ニーズの変化**  
差別化技術の多様化



## 多様化への対応

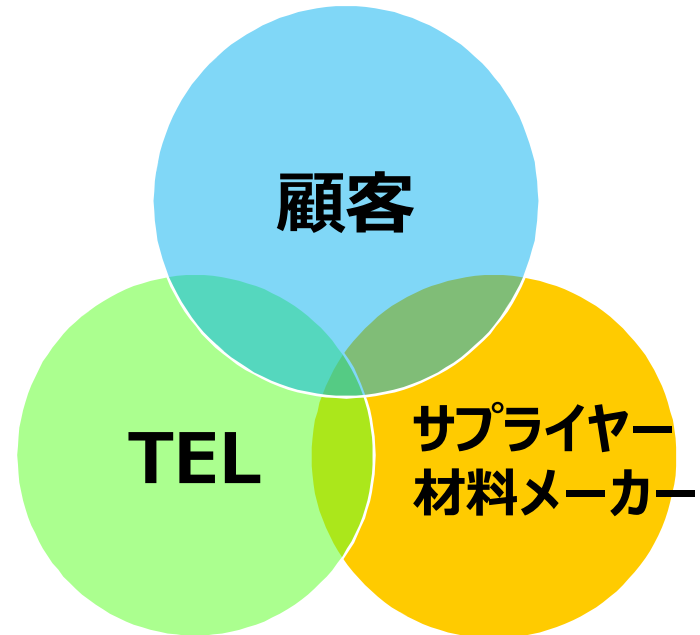
- 顧客の**差別化、カスタム化**の真のニーズを捉える
- 総合的に**技術力を結集してスピーディーにソリューションを提案**する



“Best Fit in New Market”

# グローバル成長戦略

---



**TELのDNA「強固な信頼関係を作る力」を  
最大限にいかし、顧客と固く連携  
困難な技術ハードルを越える**

## 新組織へ移行

---

### 組織改革のポイント:

- **COOを新設**
- **迅速な業務執行を可能とするCSS**
- **幅広い知見、若い世代をマネジメントに起用**
- **グローバルな人材活用**

**顧客の期待以上のものを提供する  
「顧客ニーズ創造型」企業へ**

CSS: Corporate Senior Staff

# 目標達成に向けた主要な取り組み

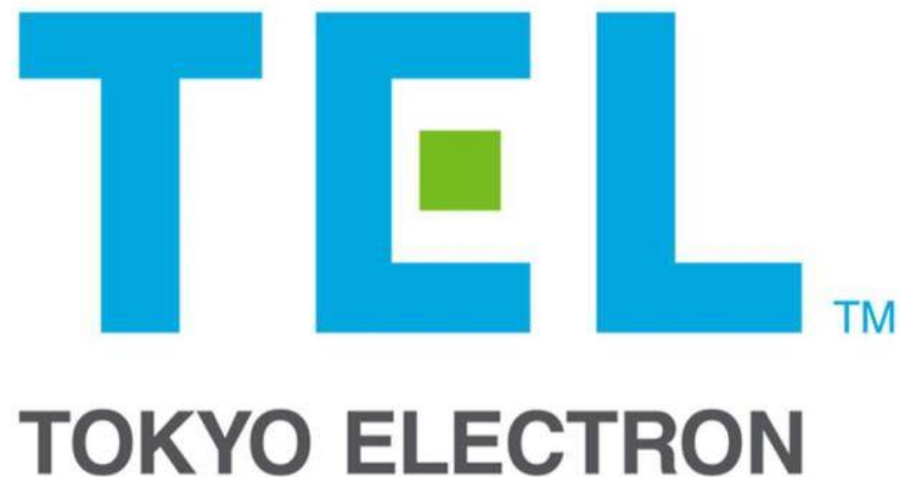
---

- **主力事業の圧倒的差別化**
- **顧客ニーズ創造型へシフト**
- **成長と技術革新を実現する基盤強化**
- **オペレーションの効率化**
- **グローバル人材の活用**

# 新コーポレートブランドロゴ

---

## 新コーポレートブランドロゴ



- ロゴのセンターに位置する正方形が、TELのテクノロジーの精度の高さを表し、同時に産業や社会の発展の核を担うコアテクノロジーを象徴
- 若々しい生命感のあるグリーンが、TELの事業の中心に人と自然環境があることを表現
- 洗練された普遍的な造形は、TELの絶対的な信頼感と存在感を示し、組織の公明正大さを表す
- グローバルエクセレンスを目指すにあたり、グローバルに通用するデザインを採用

# 中期経営計画

---

代表取締役副社長、COO 河合 利樹

2015年7月10日



TOKYO ELECTRON

# 市場環境

ネットワーク社会へ

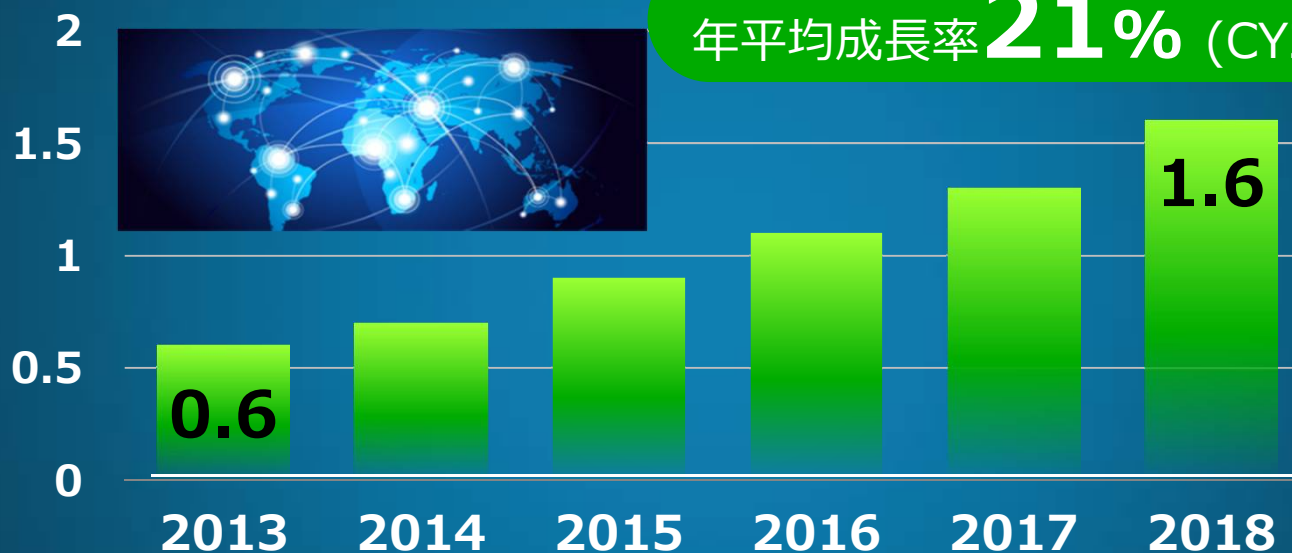


半導体はまだ黎明期の段階

# 市場環境

## 世界のデータ通信量 (IPトラフィック)

ゼタバイト/年

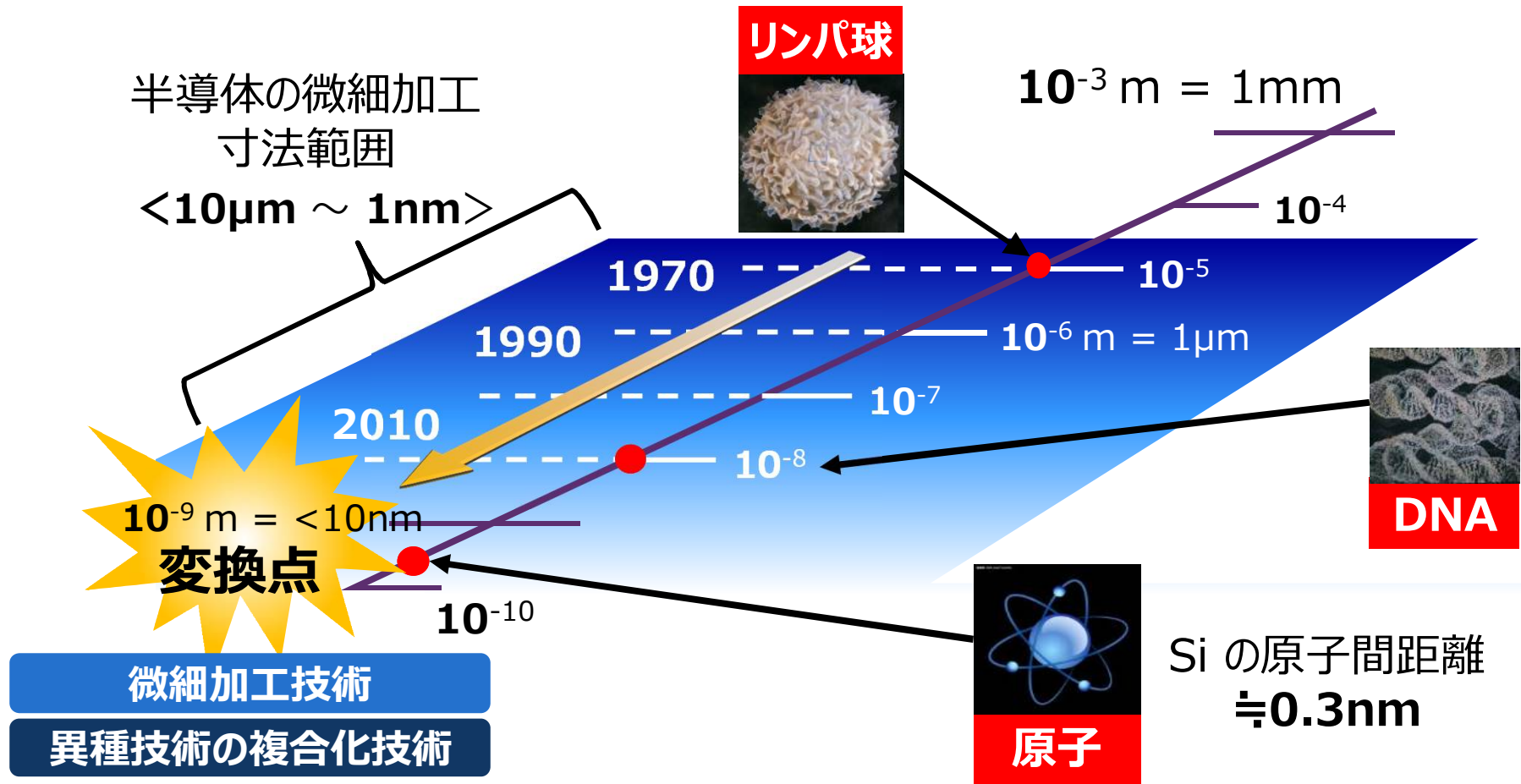


Cisco Visual Networking Index (VNI) 2013-2018年

## データ通信量は、今後爆発的に増加

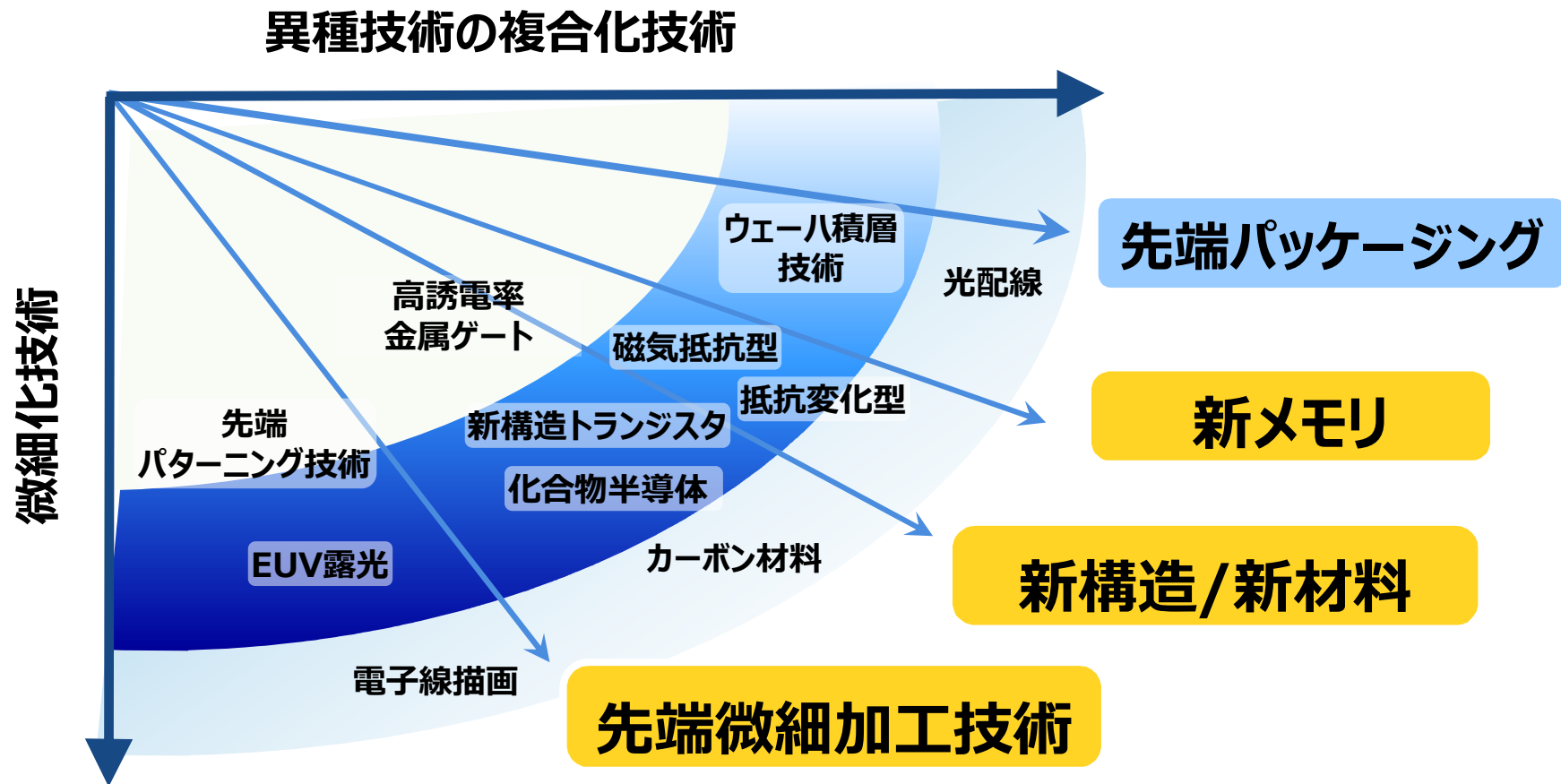
1ゼタバイト： デジタルデータの量やコンピュータ記憶装置の大きさを表す単位。10の21乗バイト。世界中の砂浜の砂の数。

# 変換点を迎える半導体技術



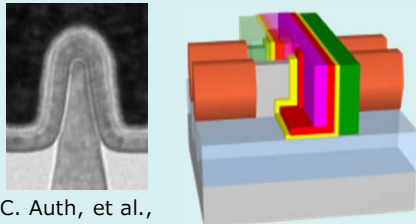
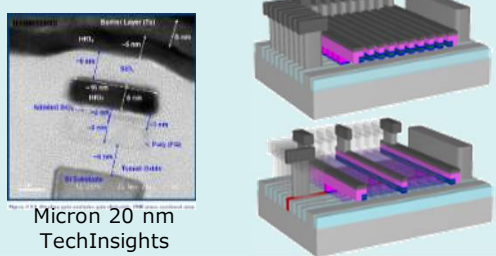
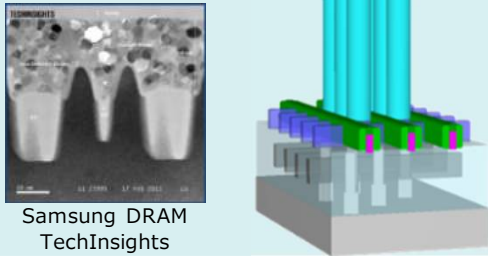
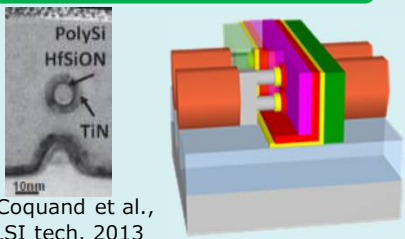

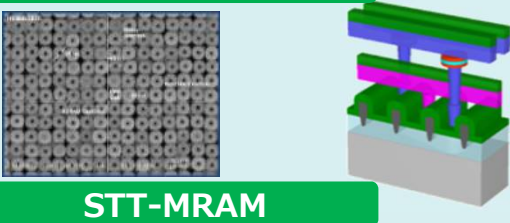


# 半導体産業におこる技術革新の方向性



多岐にわたる新技術が半導体の進化を支える

# 技術トレンド：量産 & 次世代デバイス

	先端ロジック	フラッシュメモリ	DRAM
量産 (現在)	<p>16/14nm (第二世FinFET)</p>  <p>C. Auth, et al., VLSI tech. 2012</p>	<p>2D FG-NAND 15 nm</p>  <p>Micron 20 nm TechInsights</p>	<p>~20nm</p>  <p>Samsung DRAM TechInsights</p>
次世代 (2018~)	<p>7nm (ナノワイヤ、新材料)</p>  <p>R. Coquand et al., VLSI tech. 2013</p>	<p>3D NAND 64段積層</p>  <p>Close-up image of V-NAND flash array</p>	<p>1x/1y微細化継続</p>  <p>STT-MRAM</p>
技術変換点	<p>課題：スピード・低消費電力</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>3次元構造化(Fin FET)</li> <li>新構造 (ナノワイヤ)</li> <li>新材料</li> </ul>	<p>課題：高集積化</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>3D積層化</li> <li>高アスペクト構造に対応したエッチング、成膜技術</li> </ul>	<p>課題：キャパシタ容量</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>高アスペクトエッチング</li> <li>キャパシタ材料のALD化</li> <li>一部MRAMへ置換見込</li> </ul>

## 技術変換点の見極めとソリューションの提供

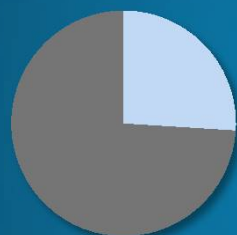
# SPE競争状況

## 当社製品の市場シェア (CY2014)

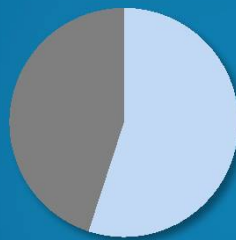
圧倒的競争力



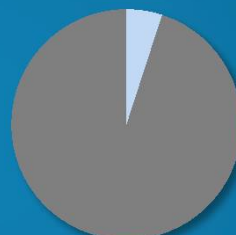
塗布現像



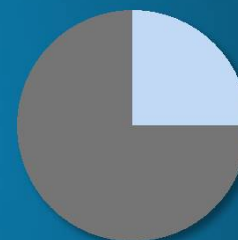
エッチング



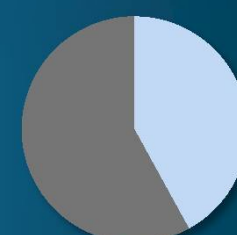
熱処理成膜



枚葉成膜



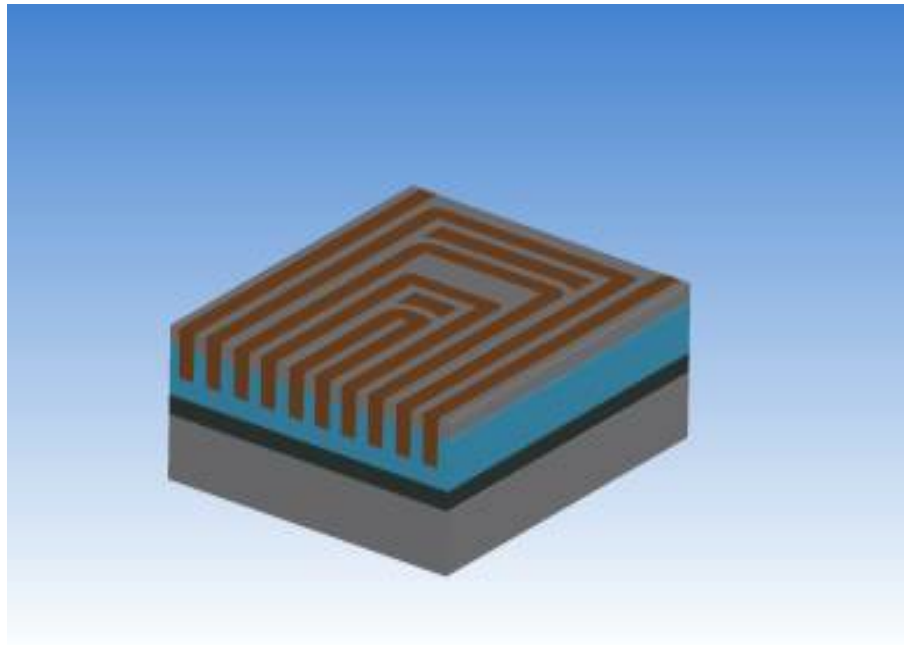
洗浄



ウェーハ  
プローバ

出所：Gartner

# SPE製品：パターニングにおける幅広い製品ラインナップ



Process Finished



Clean Track

*LITHIUS Pro™ Z*



ALD Film Deposition

*NT333™, Triase+™ EX-II™,  
TELINDY PLUS™ IRad*



Dry Etch

*Tactras™*



CVD Film Deposition

*Triase+™ CVD, TELINDY PLUS™*



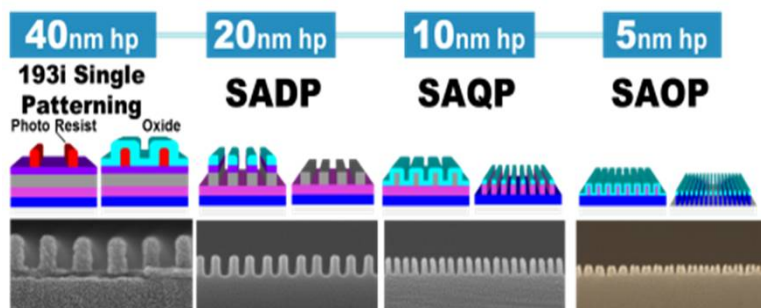
Wet Cleaning

*CELLESTA™ -i*

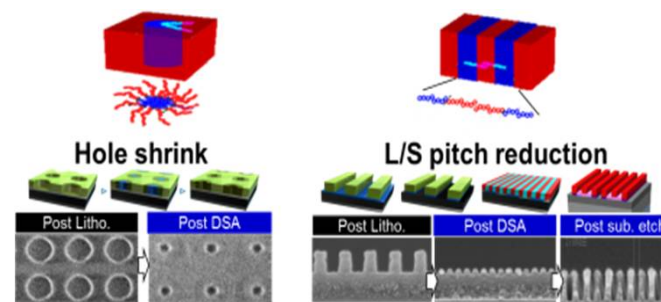
# SPE事業戦略：パターニングにおける技術提案力強化

## “Patterning Solution Project”設立

幅広い製品群を活かし最先端技術ニーズに対応



マルチパターニング技術



DSA\*技術

\*Directed Self-Assembly：誘導自己組織化技術

# SPE事業戦略：STT-MRAM開発



ガスクラスター  
イオンビーム装置



枚葉洗浄装置



エッチング・CVD  
クラスター装置



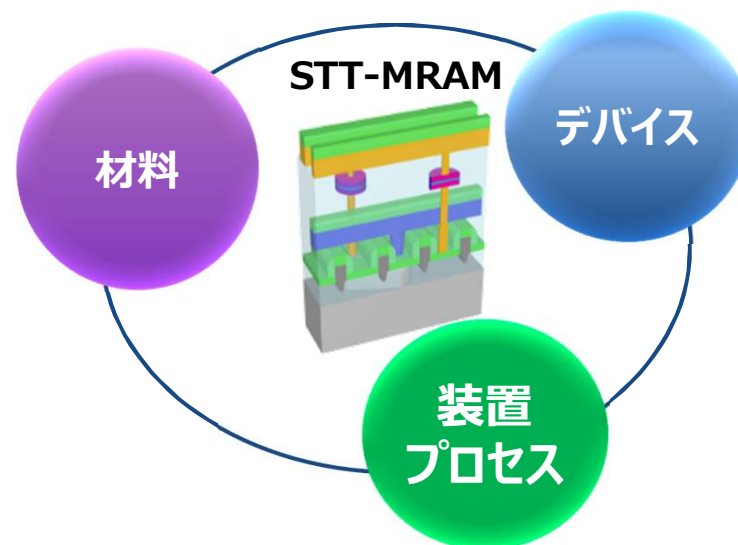
磁場中アニール装置



MTJスパッタリング装置

- ・ 顧客・東北大学・コンソーシアと共同で開発を強かに推進
- ・ 業界の実用化に向けた開発をリード

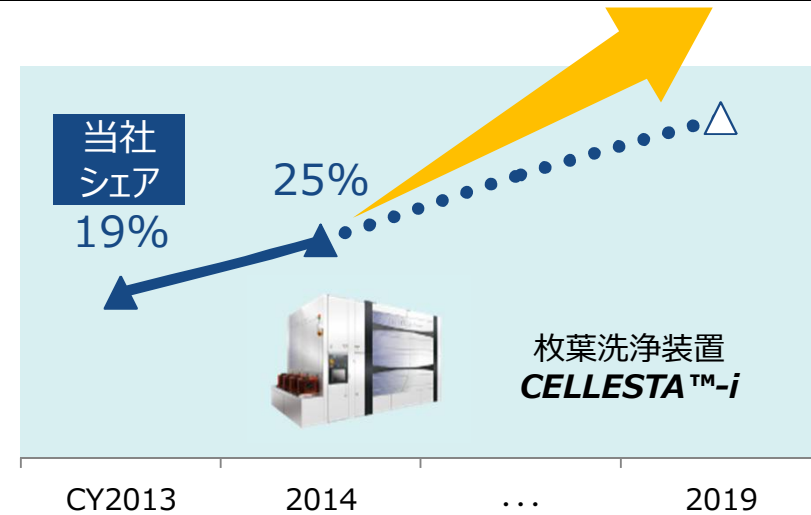
STT-MRAM: Spin Transfer Torque-Magnetoresistive Random Access Memory



# SPE事業戦略：装置別トピックおよび重点戦略

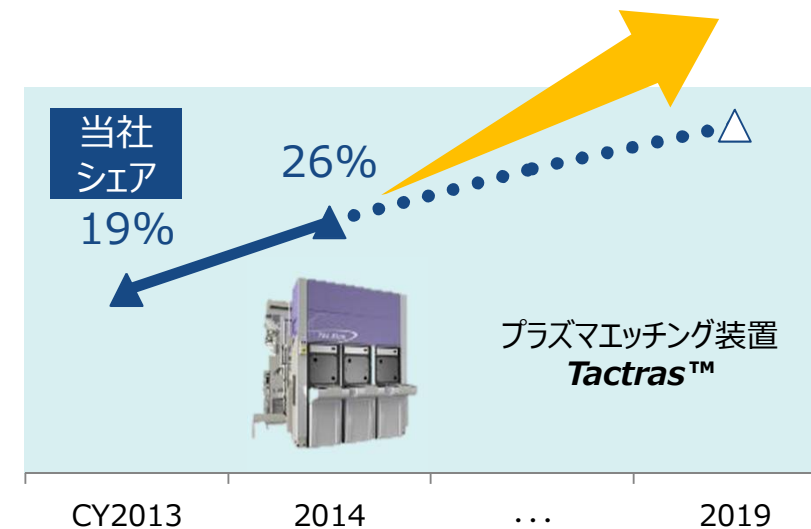
## 洗浄装置

- 2014年 過去最高のシェア
- 顧客先端ラインにおける独自技術製品の量産展開が予定通り進捗
- 枚葉洗浄、ドライ洗浄装置の適用アプリケーションを拡大し、更にシェア向上



## エッチング装置

- 2014年 対前年比で売上倍増、シェア向上
- 今後拡大するパターンニング工程とメモリ向けHARC工程におけるPOR獲得



POR (Process of Record): 顧客半導体製造プロセスでの装置採用認定  
HARC: High Aspect Ratio Contact

出所：2013および2014年実績値Gartner、弊社推定値

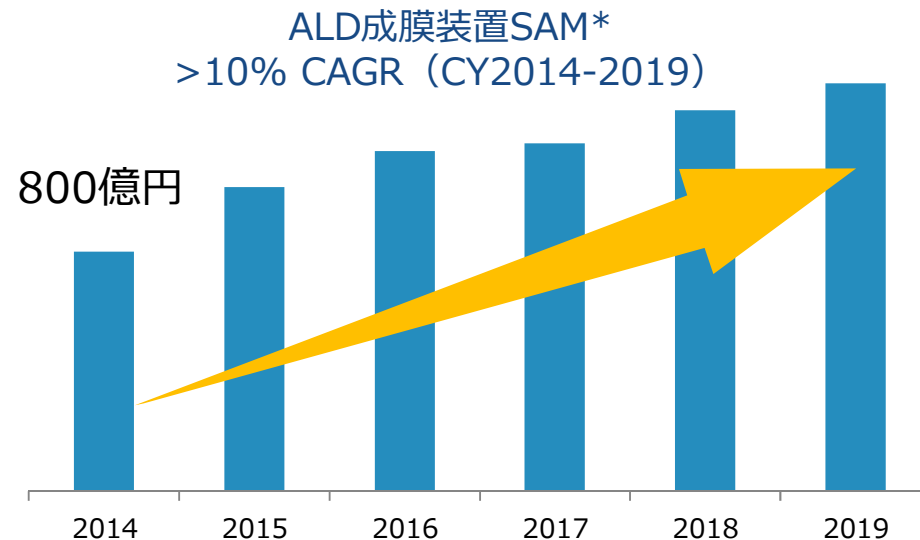
# SPE事業戦略：装置別トピックおよび重点戦略

## ALD成膜装置

- 微細化、3D化で求められる高カバレッジ、高生産性ニーズに対応
- 高生産性、高品質膜で差別化されたセミバッチALD装置NT333で、ロジック、メモリー大手顧客でPORとシェア獲得を見込む



ALD成膜装置  
NT333™



\*SAM: Served Available Market(製品対象市場) 出所： 当社推定値



# SPE事業戦略：フィールドソリューション事業の強化

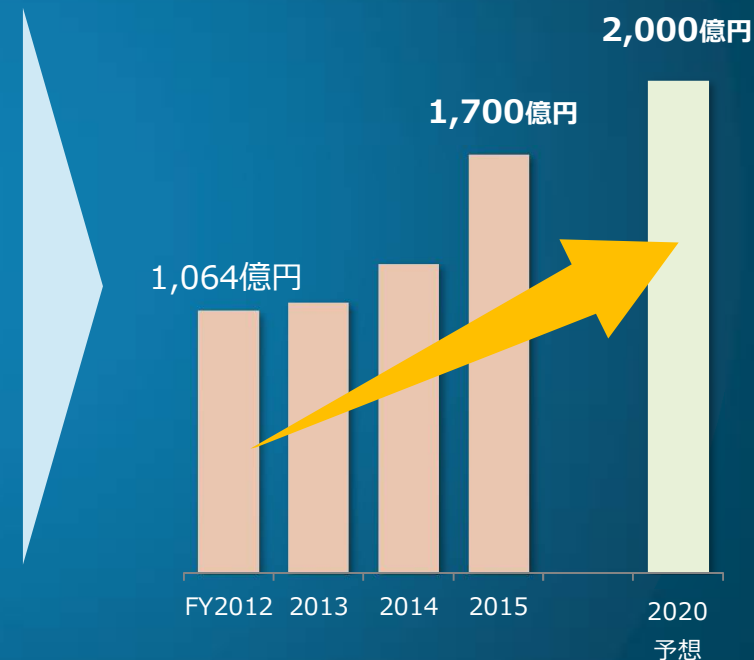
## ビジネス機会の拡大

IoT時代到来で  
多様な半導体技術が求められる

データ通信量（IPトラフィック）の  
爆発的な増大＝半導体成長

当社54,000台の  
インストールベース

## 既存ラインの顧客ニーズサポート



フィールドソリューション事業の売上は、SPE部門およびFPD部門売上に含まれています。

## IoT時代を背景にフィールドソリューションの事業機会が増大

# 半導体製造装置事業の新組織

## “強みを磨く”新たな執行体制と組織

- 顧客からの絶対的信頼という強みを磨く
- アカウト・リージョン制導入
- 各BUコア技術とノウハウの融合を活かした付加価値製品の創出
- パターニングソリューションプロジェクト発足
- 各工場・開発拠点の価値創造力と効率性の最大化

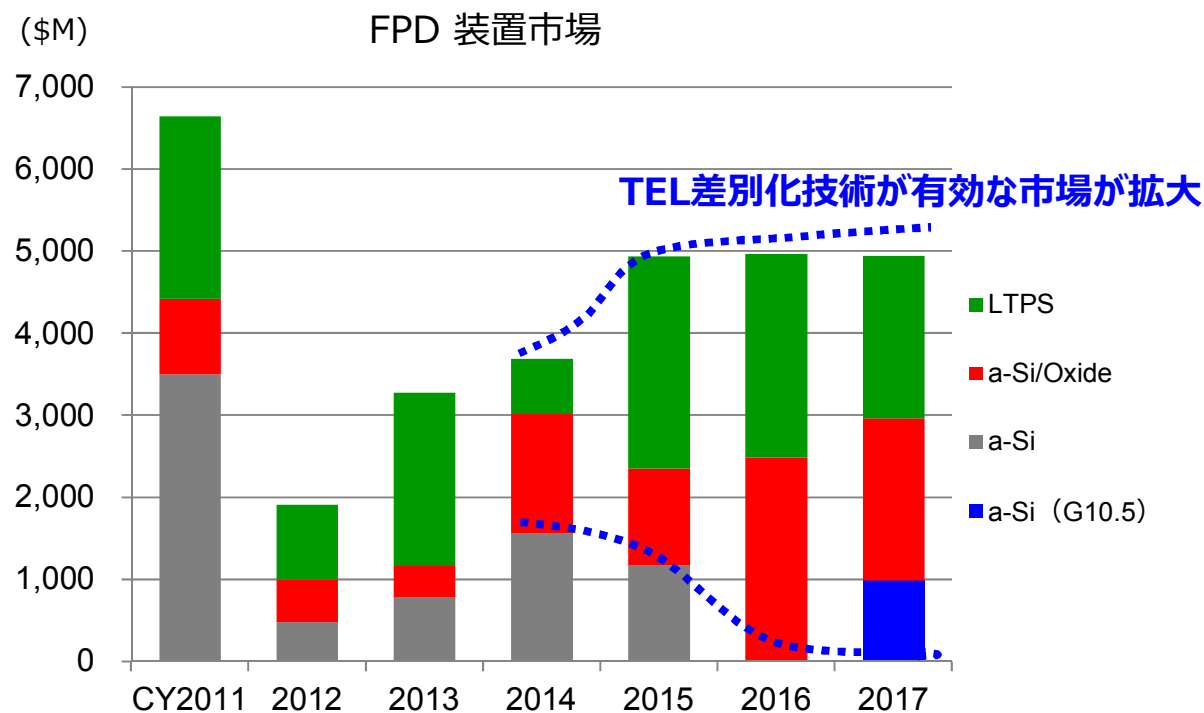
グローバル・フィールド  
統括本部

事業推進統括本部

開発・製造統括本部

# FPD事業戦略

パネルの大型化、Smart Phone向けに、高解像度需要が増大  
成長するLTPS/Metal Oxide市場にて、差別化された当社ICP\*エッチング装置を投入



Source : Display Search Data/TEL Marketing

## シェアと収益性を向上、20%の営業利益率をめざす

\* ICP : Inductively Coupled Plasma

## まとめ

---

収益改善、ROEの更なる向上に向けて

- **SPE事業に注力**
- **製品群を活かし多様化するニーズに対応**
- **“強みを磨く”新たな組織と執行体制**

# 財務モデルおよび株主還元策

---

取締役常務執行役員 堀 哲朗

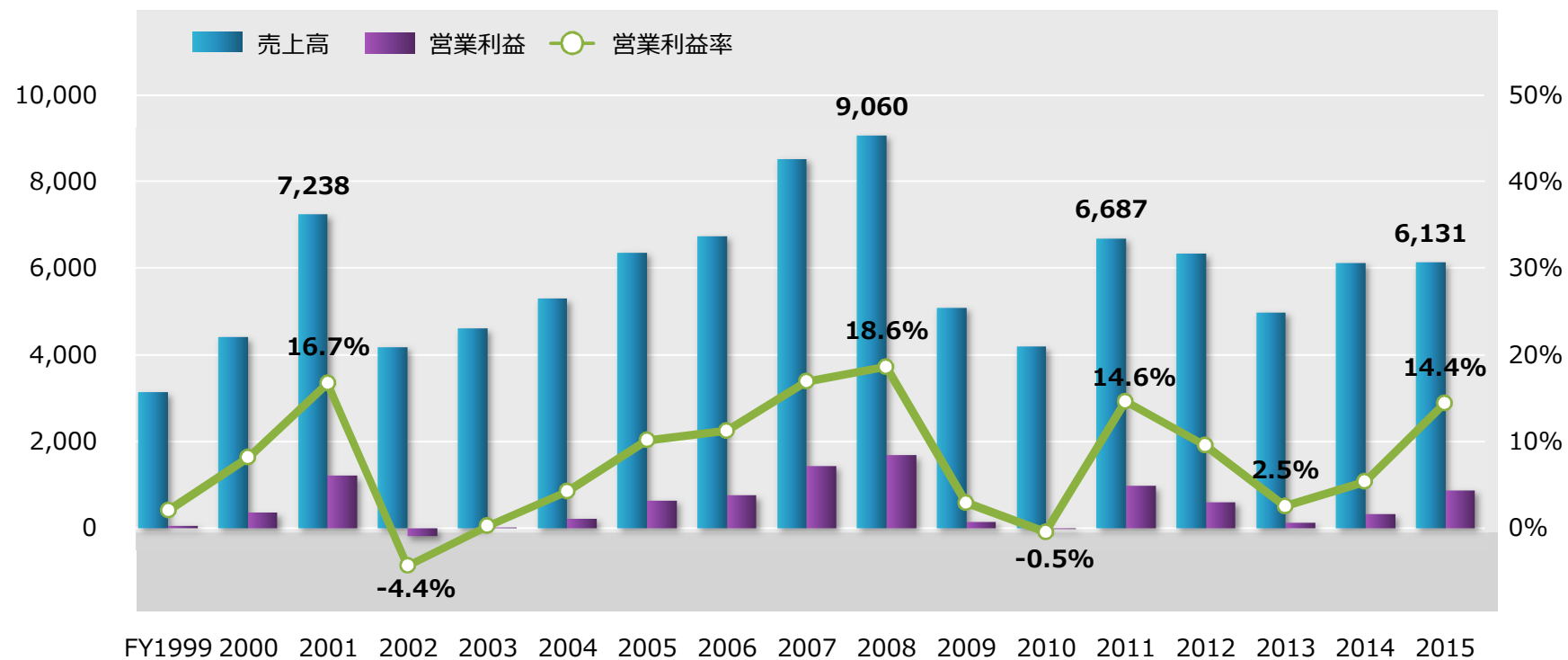
2015年7月10日



TOKYO ELECTRON

# これまでの業績推移

(億円)



# 財務モデル（2020年3月期までに達成）

➤ WFE \$37BでOPM 25%を達成する収益力を構築

(億円)

	2016年3月期 (予想)	2020年3月期 (中期計画)	
	WFE 33.5B	WFE \$30B	WFE \$37B
売上高	6,750	7,200	9,000
SPE	6,250	6,600	8,400
FPD	470	600	600
売上総利益	2,650	3,050	3,950
下段：売上総利益率	39%	42%	44%
販管費	1,530	1,600	1,700
下段：売上高販管費比率	23%	22%	19%
営業利益	1,120	1,450	2,250
下段：営業利益率	17%	20%	25%
当期純利益	790	1,000	1,550

# SPE売上 (WFE \$37Bケース)

## ➤ 市場成長を上回る売上増加を計画

(億円)

	2016年3月期 (予想)	2020年3月期 (中期計画)	成長率
	WFE \$33.5B	WFE \$37B	WFE +10%
売上高	6,250	8,400	+34%
新規装置販売	4,650	6,500	+40%
フィールドソリューション	1,600	1,900	+19%

- 顧客ニーズ創造型の製品開発を強化
- フィールドソリューション分野の需要拡大に対応



# FPD売上

## ➤ 差別化が可能な先端分野で売上拡大を計画

(億円)

	2016年3月期 (予想)	2020年3月期 (中期計画)	成長率
売上高	470	600	+28%
新規装置販売	380	480	+26%
フィールドソリューション	90	120	+33%

- 最先端の製造プロセスにおいて技術的な優位性をもつ  
エッチング装置やOLED成膜装置に注力

# 売上総利益(WFE \$37Bケース)

## ➤ 売上総利益率を5pts向上

(億円)

	2016年3月期 (予想)	2020年3月期 (中期計画)	増加率
売上総利益 下段：売上総利益率	2,650 39%	3,950 44%	+49% +5pts

- 製品競争力強化により限界利益率を向上
- フィールドソリューション事業の拡充
- 技術の共有化によるコスト削減
- 設計段階からのコスト削減、生産リードタイム短縮、品質の追求

## 販管費(WFE \$37Bケース)

### ➤ 売上高販管費比率を4pts改善

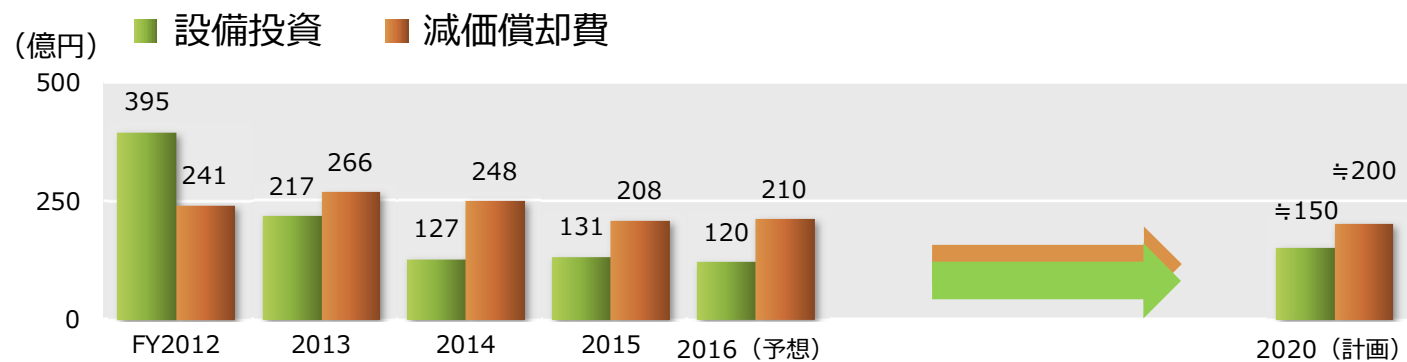
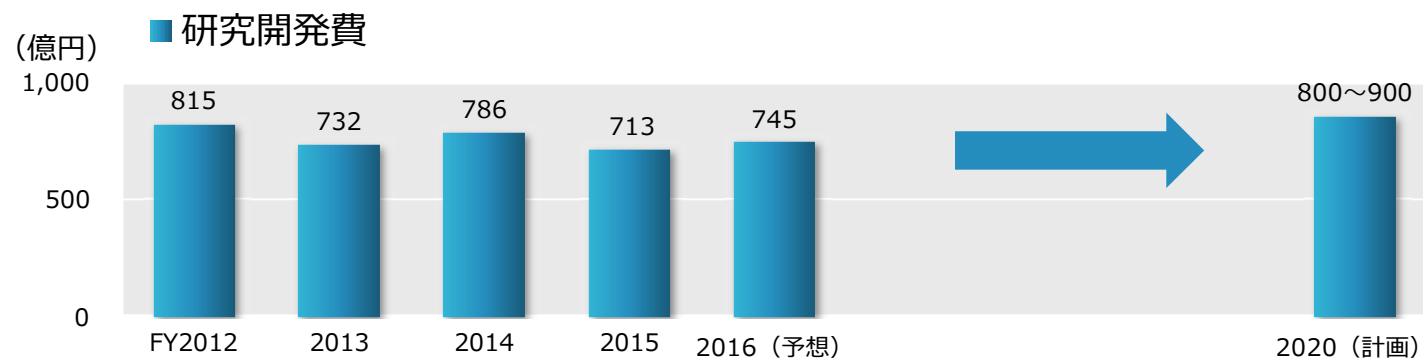
(億円)

	2016年3月期 (予想)	2020年3月期 (中期計画)	増加率
販管費	1,530	1,700	+11%
下段：売上高販管費比率	23%	19%	-4pts

- アカウント制組織のもと、リージョンのセールスマーケティングおよびフィールドエンジニアを強化し、オペレーションの効率を追求
- 開発項目を半導体中心に厳選する

# 研究開発費および設備投資計画

- 成長に必要な開発は、効率を高めつつ実施していく  
設備投資は現状の水準を維持



## 目標とする経営指標

---

- 目指すのは、グローバル水準の収益力

<b>WFE市場</b>	<b>\$30B</b>	<b>\$37B</b>
<b>営業利益率</b>	<b>20%</b>	<b>25%</b>
<b>ROE</b>	<b>15%</b>	<b>20%</b>

# 資本政策と株主還元

---

## ➤ 資本効率についての考え方

- 当社の参画する事業環境を踏まえ必要な手元流動性を確保しながら、利益の最大化を図り、株主資本の効率を求め総資産回転率を高めることで、ROEの向上を図る。

## ➤ 株主還元についての考え方

- 事業ボラティリティが高いため、配当政策については業績連動型を基本とする。
- 強固な財務基盤を活かし、一株当たり配当金の下限を新たに定め、より安定的に株主に報いる。

# 新しい株主還元策

---

**連結配当性向： 50%**

**但し、一株当たり年間配当金150円を下回らない**

**2期連続して当期利益を生まなかった場合は、  
配当金の見直しを検討する**

---

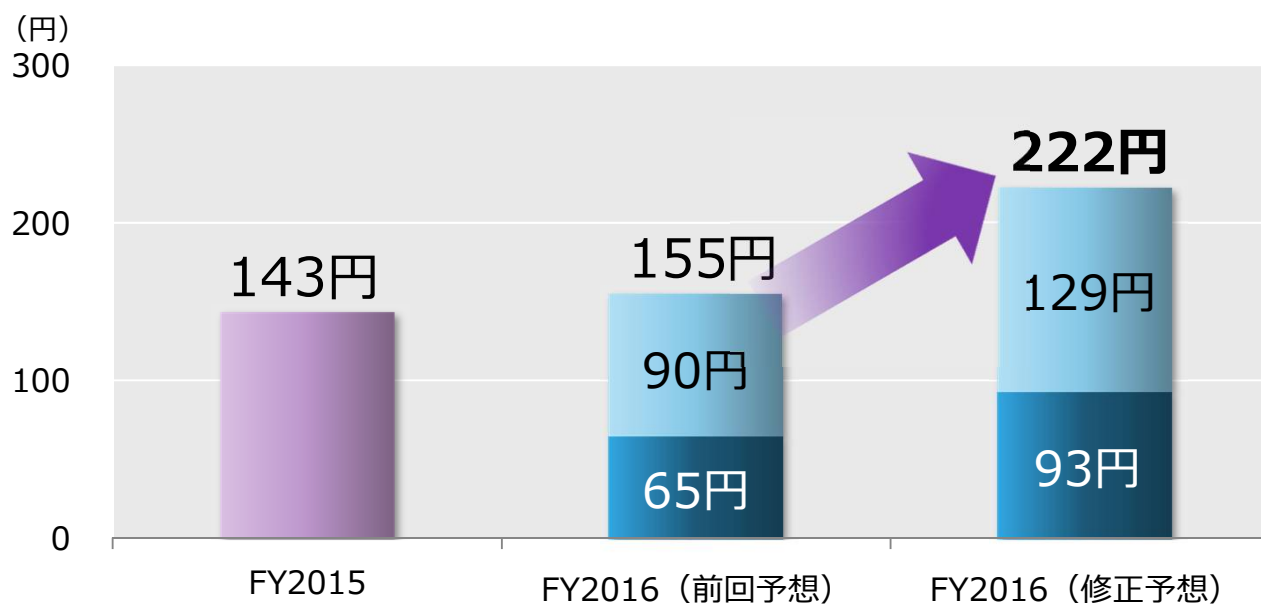
**自己株式の取得： 機動的に実施を検討**

従来の配当政策は、FY2011の期末配当より連結配当性向を35%目途としておりました。

## 2016年3月期 配当予想 (2015年7月10日発表)

➤ 新しい株主還元策にもとづき、配当予想を修正

1株当たり配当金 (予想)		
中間配当	期末配当	合計
93円	129円	222円



FY2016より、新しい株主還元策として、配当性向を従来の35%目途から50%目途に引き上げています。

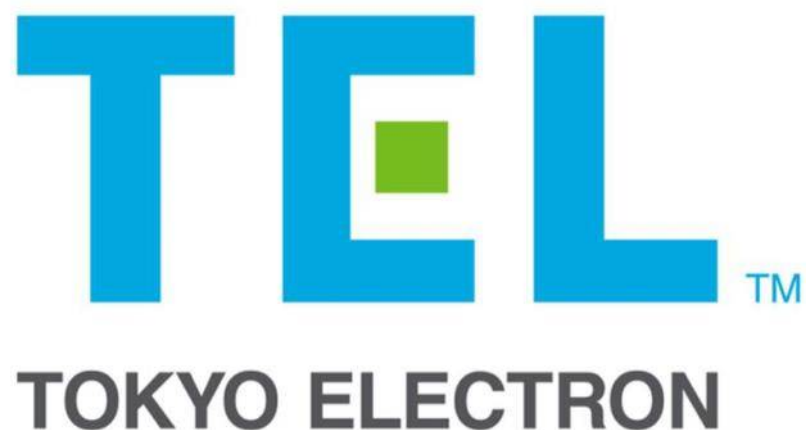


## まとめ

---

市場成長をアウトパフォームし、  
企業価値のさらなる向上を目指す

新コーポレートブランドロゴ



---

## ▶ 将来見通しについて

本資料に記述されている当社の業績予想、将来予測などは、当社が作成時点で入手可能な情報に基づいて判断したものであり、経済情勢、半導体/FPD/PV市況、販売競争の激化、急速な技術革新への当社の対応力、安全・品質管理、知的財産権に関するリスクなど、様々な外部要因・内部要因の変化により、実際の業績、成果はこれら見通しと大きく異なる結果となる可能性があります。

## ▶ 数字の処理について

記載された金額は単位未満を切り捨て処理、比率は1円単位の金額で計算した結果を四捨五入処理しているため、内訳の計が合計と一致しない場合があります。

## ▶ 為替リスクについて

当社の主力製品である半導体製造装置及びFPD/PV製造装置の輸出売上は、原則円建てで行われます。一部にドル建ての決済もありますが、受注時に個別に先物為替予約を付し、為替変動リスクをヘッジしています。従って、為替レート変動による収益への影響は極めて軽微です。

FPD/PV:フラットパネルディスプレイ及び太陽光パネル